



1. 芯片特征

- (1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3) $V_{RRM} \geq 1600V$
- (4) 正面金属层:AL或Ti-Ni-Ag
- (5) 背面金属层:Ti-Ni-Ag

2. 芯片尺寸

- (1) 4.3mm×4.3mm

3. 主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用



4. 产品极限参数

参数名称	符号	单位	测试条件	数值
反向重复峰值电压	V_{RRM}	V	$T_j=25^\circ C, I_{RRM}=5\mu A$	1600
反向不重复峰值电压	V_{RSM}	V	$T_j=25^\circ C, I_{RSM}=5\mu A$	1700
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	A	$T_s=80^\circ C, T_j=150^\circ C$	16
正向浪涌电流	I_{FSM}	A	$tp=10ms, \sin 180^\circ, T_j=150^\circ C$	190
电流时间积分	I^2t	A^2s	$T_j = 150^\circ C, tp=10ms, \sin 180^\circ$	180
结温范围	T_j	$^\circ C$		-40 ~ 150

5. 其他检查标准

参数名称	符号	单位	测试条件	标准数值			检验数量	
				最小值	平均值	最大值		
反向漏电流	I_R	mA	$V_R=1600V$	$T_j=25^\circ C$	-	-	0.1	抽检(5%)
				$T_j=145^\circ C$	-	-	1.2	
正向压降	V_F	V	$I_F=5A, T_j=25^\circ C$, 芯片测试	-	0.9	1	全数	
外观检验	(1) 玻璃裂纹		-	-	-	全数		
	(2) 金属层侵蚀		-	-	-			

6. 芯片结构

名称	符号	单位	尺寸	说明
芯片尺寸	U	mm	4.3 ± 0.05	
沟槽尺寸	W	mm	3.4 ± 0.1	
金属尺寸	X	mm	3.3 ± 0.1	
芯片厚度	Y	μm	300 ± 10	
沟槽深度	Z	μm	140 ± 20	
AL金属层厚度		μm	7 ± 1	
Ti-Ni-Ag金属层厚度		μm	1.5~2.0	

